学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

清华大学薛其坤教授增选为中国科学院院士(图)

http://www.fristlight.cn

2005-12-20

[作者]清华大学新闻中心

[单位]清华大学新闻中心

[摘要] 2005年12月16日,2005年中国科学院院士增选评审结果在京揭晓,清华大学物理系薛其坤教授(技术科学部)被新增选为中国科学 院院士。

[关键词]清华大学;教授;中国科学院;院士



2005年12月16日,2005年中国科学院院士增选评审结果在京揭晓,清华大学物理系薛其坤教授 (技术科学部)被新增选为中国科学院院士。根据《中国科学院院士章程》的规定,中国科学院院士 增选每两年进行一次,2005年增选名额限60名。经国务院有关部委、直属机构,中国人民解放军四总 部,各省、自治区、直辖市和中国科协等归口初选部门的推荐和院士推荐,共产生有效候选人295名。 经过充分讨论、全面评审,最终选举产生了51名新院士,其中数学物理学部8名,化学部9名,生命科 学和医学学部12名, 地学部7名, 信息技术科学部6名, 技术科学部9名。截止目前为止, 清华大学共有 中国科学院院士35人。薛其坤,男,1963年12月出生。山东蒙阴人。中科院表面物理国家重点实验室 主任,国家纳米科学中心首席科学家,清华大学物理系教授,教育部"长江奖励计划"特聘教授。 1984年毕业于山东大学光学系,1990年在中国科学院物理研究所获硕士学位,1994年获博士学位。1992 到1999年间在日本和美国长期学习、工作。主要学术兼职有中国物理学会表面与界面物理专业委员会 副主任委员,国家自然科学基金委员会第九届信息学部专家评审组成员,国际杂志《Surface Science》

和《Nanotechnology》的编委。 主要研究方向为表面物理、低维纳米结构和薄膜的控制生长与量子效应、极低温强磁场和自旋极化扫描 隧道显微学。长期从事超薄膜材料和纳米结构的制备、表征及其物理性能研究。开展了GaAs半导体薄膜、InAs/GaAs量子阱(点)、宽禁 带半导体GaN薄膜生长动力学研究, 发展完善了III-V族化合物半导体表面再构的基本规律,开展了半导体Si衬底上金属超薄膜量子尺寸效应 的研究,定量建立了金属薄膜体系量子效应和材料性能间内在联系,发现了薄膜热膨胀系数、功函数、超导转变温度等的量子振荡现象; 开展了有序纳米结构的自组织生长研究,发明了若干原子尺度精确控制生长技术,解决了异质外延生长纳米有序结构的难题。发表学术论 文110余篇,被引用1300多次。在物理学和相关领域较有影响的国际会议如美国物理学会年会、美国材料学会年会、美国真空学会年会、 扫描隧道显微学大会、分子束外延大会等做过30余个邀请报告。曾获国家自然科学二等奖、北京市科学技术一等奖和中国青年科技奖等奖 项。

我要入编:本站介绍:网站地图:京ICP证030426号:公司介绍:联系方式:我要投稿

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

